

General Purpose Transistors 通用三極管

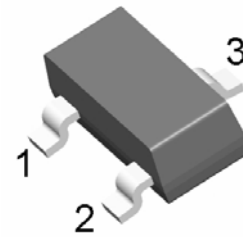
FHT5087

DESCRIPTION & FEATURES 概述及特點

Excellent h_{FE} Linearity h_{FE} 線性特性極好 $h_{FE}(0.1mA)/h_{FE}(2mA)=0.95(Typ.)$

Low Noise 低雜訊

SOT-23



PIN ASSIGNMENT 引腳說明

PIN NAME 管腳符號	PIN NUMBER 引腳序號	FUNCTION 功能
	SOT-23	
B	1	BASE
E	2	EMITTER
C	3	COLLECTOR

MAXIMUM RATINGS($T_a=25^\circ C$) 最大額定值

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	-50	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	-50	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	-3.0	Vdc
Collector Current—Continuous 集電極電流-連續	I_C	-50	mAdc
Base Current 基極電流	I_B	-30	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_c	300	mW
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_j, T_{stg}	150 , -55 ~150	$^\circ C$

DEVICE MARKING 打標

 $h_{FE} (1)$ FHT5087=2Q

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ C$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 $25^\circ C$)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-10V, I_E=0$	—	—	-10	nA
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-1.0mA$	-50	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-100\mu A$	-50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-100\mu A$	-3	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	h_{FE}	$V_{CE}=-5V, I_C=-100\mu A$	250	—	800	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-10mA, I_B=-1.0mA$	—	—	-0.3	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-10mA, I_B=-1.0mA$	—	—	-0.85	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=-5.0V, I_C=-500\mu A$	40	200	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	$V_{CB}=-5V, I_E=0, f=1MHz$	—	2.0	4.0	pF
Noise Figure 雜訊係數	NF	$R_S=3.0kV_{CE}=-5.0Vdc, I_C=-100\mu A, f=1.0KHz$	—	1.0	2.0	dB